

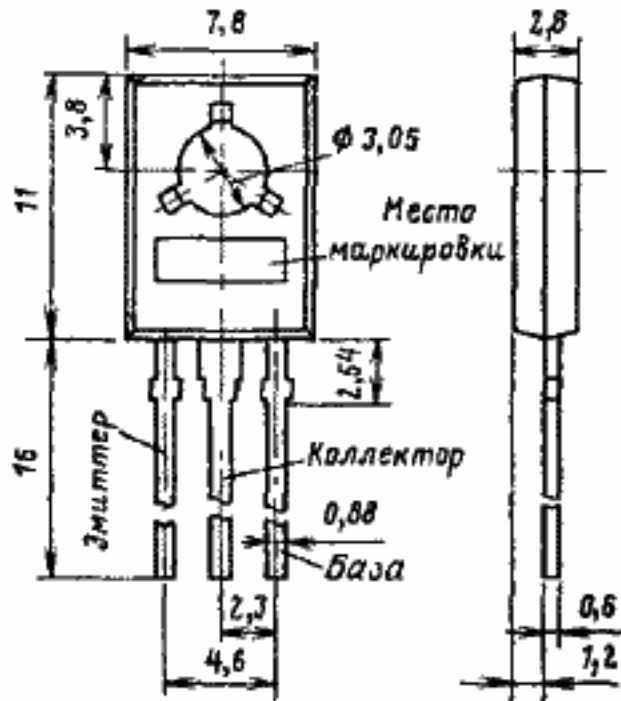
# КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные мощные

Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 0,7 г.



## Электрические параметры

Граничное напряжение при  $I_3 = 100$  мА,  $\tau_n \leq 300$  мкс,  
 $Q \geq 100$  не менее:

КТ817А . . . . .	25 В
КТ817Б . . . . .	45 В
КТ817В . . . . .	60 В
КТ817Г . . . . .	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_K = 1$  А,  $I_B = 0,1$  А не более . . . . . 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_K = 1$  А,  $I_B = 0,1$  А не более . . . . . 1,5 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 2$  В,  $I_3 = 1$  А не менее:

при $T = 298$ К и $T = 373$ К . . . . .	25
при $T = 233$ К . . . . .	15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 10$  В,  $I_3 = 0,25$  А не менее . . . . . 3 МГц

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 10$  В,  $f = 1$  МГц не более . . . . . 60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ} = 0,5$  В не более 115 пФ

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 40$  В КТ817А; при  $U_{КБ} = 45$  В КТ817Б, при  $U_{КБ} = 60$  В КТ817В; при  $U_{КБ} = 100$  В КТ817Г не более:

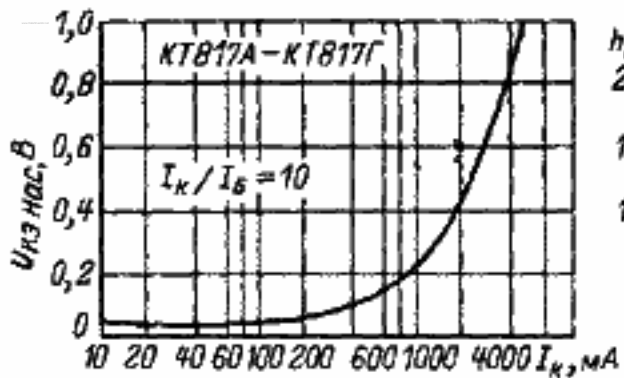
при $T = 233$ и $298$ К . . . . .	100 мкА
при $T = 373$ К . . . . .	3000 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

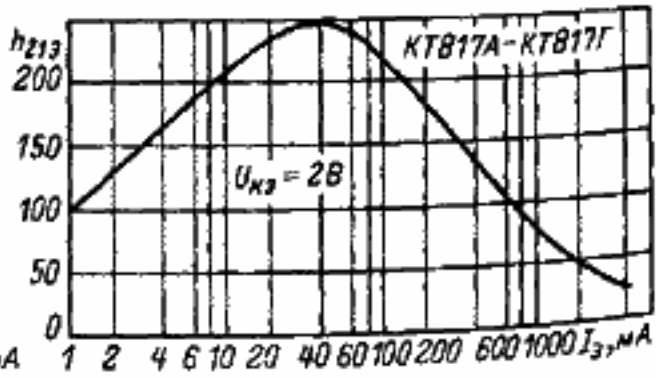
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} = \infty$ ,  $T_K = 233 \div 373$  К:

КТ817А . . . . .	25 В
------------------	------

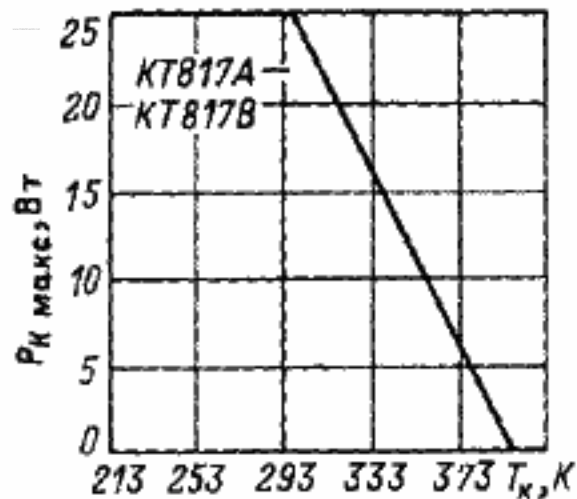
—	КТ817Б . . . . .	45 В
	КТ817В . . . . .	60 В
	КТ817Г . . . . .	80 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм, $T_k = 233 - 373$ К		
	КТ817А . . . . .	40 В
	КТ817Б . . . . .	45 В
	КТ817В . . . . .	60 В
	КТ817Г . . . . .	100 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $T_k = 233 - 373$ К		5 В
Постоянный ток коллектора при $T_k = 233 - 373$ К . . . . .		3 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_H \leq 20$ мс, $Q \geq 100$ , $T_k = 233 - 373$ К . . . . .		6 А
Постоянный ток базы при $T_k = 233 - 373$ К . . . . .		1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_k = 233 - 298$ К . . . . .		25 Вт
без теплоотвода при $T = 233 - 298$ К . . . . .		1 Вт
Температура перехода . . . . .		423 К
Температура окружающей среды . . . . .		От 233 до $T_k = 373$ К



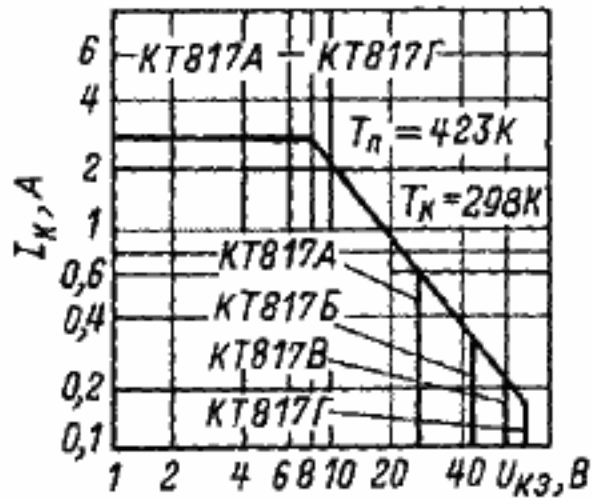
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса



Область максимальных режимов